КП7129А

КРЕМНИЕВЫЙ ЭПИТАКСИАЛЬНО-ПЛАНАРНЫЙ ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР

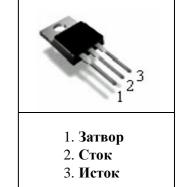
АДБК 432140.110 ТУ

КРЕМНИЕВЫЕ ЭПИТАКСИАЛЬНО-ПЛАНАРНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ С ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ, ОБОГАЩЕНИЕМ N-КАНАЛА И ВСТРОЕННЫМ ОБРАТНОСМЕЩЕННЫМ ДИОДОМ. ПРЕДНА-ЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ДРАЙВЕРАХ, БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ НАПРЯЖЕНИЯ, ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ АНАЛОГОВЫХ СХЕМАХ, ТЕЛЕКОМУНИ-КАЦИОННОЙ АППАРАТУРЕ И ДРУГОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУ-

* Зарубежный аналог - **ssulun60**

* Изготавливается в корпусе **КТ-28-2 (ТО-220АВ).** ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры	Обозна- чение	Ед. изм.	Предельные значения	
Напряжение сток-исток	Uc и max	В	600	
Напряжение затвор-исток	Uзи max	В	±20	
Постоянный ток стока	Ic max	A	1,2	
Импульсный ток стока	Іс и тах	A	4,8	
Рассеиваемая мощность	Pmax	Вт	40	
Прямой ток диода	Іпр. тах	A	1,2	
Температура перехода	Тпер	°C	150	



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Токр.ср.=25°C)

Параметры	Обозначе- ние	Ед.изме- рения	Режимы измерения	Min	Max
Пороговое напряжение	Uзи пор	В	Іс=250мкА, Изи=Иси	2.0	4.0
Ток стока	Ic	A	tи ≤300мкс. Q ≥50 Ucи=18B,Uзи=10B	1,2	
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии	Р СИ ОТК	Ом	tи ≤300мкс. Q ≥50 Ic=0,6A,Uзи=10B		11,5
Остаточный ток стока	Іс ост	мкА	Uси=Uси max, Uзи=0		10
Ток утечки затвора	Із ут	нА	Uси=0,Uзи=±20В	-100	+100
Кругизна ВАХ	S	A/B	tи ≤300мкс. Q ≥50 Ucu=25B,Ic=0,6A	0,6	
Прямое напряжение диода	Uпр	В	tи ≤300мкс. Q ≥50 Ic=-1,2A,Uзи=0В		1,4
Время включения/выключения	* tвкл/ tвыкл	нс	tи ≤300мкс. Q ≥50, Ucи=300B,Ic=1,2A, Rг=50 Ом,		80/85
Тепл. сопрот. переход-корпус	* Rt п-к	°C/BT			3,13
Входная емкость	* С11и	пФ	Uзи=0,Uси=25В, f=1МГц		280
Выходная емкость	* С _{22и}	пΦ	Uзи=0,Uси=25В, f=1МГц		40
Проходная емкость	* С _{12и}	пΦ	Uзи=0,Uси=25В, f=1МГц		15

^{*} Справочные параметры

220108, г.Минск, ул. Корженевского,16 УП "Завод Транзистор" Отдел маркетинга: т/ф (10-37517) 212-59-32

E-mail: market@transistor.com.by http://www.transistor.by